## 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 23 日現在

機関番号: 1 3 8 0 1							
研究種目: 基盤研究(B)							
研究期間: 2011 ~ 2013							
課題番号: 2 3 3 6 0 1 2 2							
研究課題名(和文)マルチレベル電力変換器の新規トポロジー群創出と技術的枠組みの再構築							
研究課題名(英文)Novel Topologies Creation and Technical Framework Reconstruction of Multilevel Power Converters							
研究代表者							
野口 敏彦 (Noguchi, Toshihiko)							
静岡大学・工学(系)研究科(研究院)・教授							
研究者番号:10237828							
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,600,000円、(間接経費) 4,380,000円							

研究成果の概要(和文): 本研究では,(1)従来の回路構成,動作原理とは全く異なるマルチレベル電力変換器の新 規トポロジー群を見出し,マルチレベル技術の枠組みを拡張,再構築できた。(2)従来方式と新規トポロジー群を半導 体素子数,受動素子数,電源数,絶縁ドライブ回路数,電力変換効率,実装や制御の難易度などの観点から総合的に比 較評価し,それぞれの特徴を活かした応用に対する技術的基盤を提供できた。(3)新規トポロジー群の中から,SiC-MO SFETに代表される次世代半導体素子を利用した電力変換器のあるべき姿を提示した。

研究成果の概要(英文): The achievements of this research work are as follows: (1) Novel topologies of the multilevel power converters that have completely different circuit configurati on and operation principle have been discovered, and the framework of the multilevel technology has been e xpanded and reconstructed. (2) Comprehensive comparison of the semiconductor counts, the passive element c ounts, power supply counts, isolated drive circuit counts, power conversion efficiency and difficulty of i mplementation and control has been conducted between conventional and novel proposed topologies. and (3) S ome novel topologies are taken up for possible utilization in power converters using next-generation semic onductors such as SiC-MOSFET.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学・電力工学・電力変換・電気機器

キーワード: パワーエレクトロニクス 電力工学 電気機器工学 制御工学 マルチレベル電力変換器 電流形イン バータ トポロジー

1. 研究開始当初の背景

電力変換器の出力をマルチレベル化する ことにより、出力波形の総合歪率を大幅に改 善することができる。また、出力レベル数に 応じて使用する電力用半導体素子の定格値 を低減できると同時に,電力変換器の大容量 化を図ることが容易となるため, 主として大 容量装置への適用を目指してマルチレベル 電力変換技術が精力的に研究されている。一 方, Si (シリコン) に代わって SiC (シリコ ンカーバイド)を基材とする次世代半導体素 子がいよいよ実用に供される日が近づいて いる。このため、高速スイッチング (dV/dt  $=10^4 \sim 10^5 V/\mu s$ ), 高耐圧 (Si の 7~10 倍), 高効率 (Si に対し R<sub>on</sub>=1/200~1/500), 高温 動作(200~400℃)という卓越した諸特性を 活かす電力変換技術が切望されている。また, AC/AC 直接変換方式も有望な技術であるた め,双方向導通あるいは逆阻止能力をもった 半導体スイッチング素子の開発が今後も盛 んに行われていくと思われる。

従来,マルチレベル電力変換器の代表的な ものとして,中性点クランプ形,フライング キャパシタ形,カスケード接続形,キャパシ タセル形などが広く知られている。このよう に,国内外を通じてマルチレベル電力変換技 術は専ら電圧源形のトポロジーを軸に展開 されてきた。一方,電流源形のトポロジーは あまり研究されていないが,並列接続形,マ ルチセル形,シングルレーティングインダク タ形などが国外で提案されている。本研究は 過去に国内外で発表されたいずれとも異な る独自の回路構成と動作原理に基づくマル チレベル電力変換器の新規トポロジー群を 探索,創出するものである。

2. 研究の目的

本研究は、従来の回路構成、動作原理とは まったく異なるマルチレベル電力変換器の 新規トポロジー群を探索、創出し、マルチレ ベル電力変換器の技術的枠組みを再構築す るとともに、新たな応用に対する技術的基盤 を提供することを目的とする。以下に研究目 的を項目別に掲げる。

- (1) 独自のフィッシュボーン構造,インダク タセル,DC 電流源モジュール重畳方式な どの未開拓トポロジー群を出発点として, マルチレベル電力変換器の新たな技術領 域を拡張する。
- (2) SiC(シリコンカーバイド)などを基材と する次世代半導体素子の適用を前提とし, 大容量電力変換器に適した新規トポロジ 一群を探索,創出する。
- (3) プロトタイプによる実機検証を通じて従 来方式と新規トポロジー群の比較評価を 行う。
- 3.研究の方法

本研究では独自のフィッシュボーン構造, インダクタセル, DC 電流源モジュール重畳 方式などの未開拓トポロジー群を出発点と して、マルチレベル電力変換器の新規トポロ ジー群を探索、創出する点に学術的な特色が ある。この点で従来とは一線を画した独創的 研究である。

本研究により次の成果を期待できる。

- (1) 従来の回路構成,動作原理とは全く異なるマルチレベル電力変換器の新規トポロジー群を見出し、マルチレベル技術の枠組みを拡張,再構築することができる。
- (2)従来方式と新規トポロジー群を半導体素 子数,受動素子数,電源数,絶縁ドライ ブ回路数,電力変換効率,実装や制御の 難易度などの観点から総合的に比較評価 し,それぞれの特徴を活かした応用に対 する技術的基盤を提供することができる。
- (3) 新規トポロジー群の中から, SiC-MOSFET に代表される次世代半導体素子を利用し た電力変換器のあるべき姿を提示するこ とができる。

本研究は以下の計画・方法に基づき平成23 ~25年度の3年間にわたって実施された。

- (1) 平成 23 年度 フィッシュボーン構造, インダクタセル, DC 電流源モジュール重 畳方式などに基づくマルチレベル電力変 換器の新規トポロジー群を検討した。計 算機シミュレーションによる基本動作の 確認と予備実験を行った。
- (2) 平成24年度 新規トポロジー群に基づくマルチレベル電力変換器のプロトタイプを試作した。プロトタイプによる実機検証と種々の方式について比較評価した。
- (3) 平成25年度 新規トポロジー群を含ん だマルチレベル電力変換器の技術体系を 再構築した。次世代半導体素子の利用を 見据えた実装法検討と実験評価を行った。
- 4. 研究成果
- (1) 技術的背景

近年, IGBT や MOSFET などの電力用半導 体素子の特性が飛躍的に向上し、電力変換器 の性能改善を力強く牽引している。特に、オ ン電圧(オン抵抗)の改善とスイッチングの 高速化によって電力変換器の導通損とスイ ッチング損が低減され、変換効率の向上に大 きく寄与している。また, 高耐圧・大電流素 子は電力変換器の大容量化と電力密度の向 上を促進し,適用範囲の拡大にも貢献してい る。このような半導体素子の特性向上のほか, 電力変換器自体の回路構成および制御の工 夫による性能改善も著しい。特に, 電力変換 器のマルチレベル化は導通損やスイッチン グ損,使用素子数,制御の複雑さにおいて基 本的な2レベル電力変換器より不利であるが、 波形歪,装置容量,素子定格などの点で高い 優位性をもつ。中性点クランプ形コンバータ に代表されるように、これまで数種のマルチ レベル電力変換器が発表されてきたが、いず れも電圧源形であり,その双対にあたる電流 源形が検討されたことはほとんどない。本研



図1 電流源3レベルコンバータ(電圧源3レベル中性 点クランプ形コンバータの双対回路)



図2 電流源3レベルコンバータ(電圧源3レベル中性 点短絡形コンバータの双対回路)



図3 インダクタセルを利用した電流源5レベルコンバ ータ(電圧源5レベル縦続キャパシタセル形コンバータ の双対回路)

究では種々のマルチレベルコンバータについて電気回路の双対性を利用して新しいト ポロジーを導出し、シミュレーションや実験 によりその妥当性を検証する。

(2) 双対理論により導出されるマルチレベル コンバータの新トポロジー

② 中性点短絡形コンバータの双対回路
 図2に3レベル中性点短絡形コンバータの双対回路を示す。

③ 縦続キャパシタセル形コンバータの双対 回路 図3は5レベル縦続キャパシタセル 形コンバータの双対回路である。主回路は図 1の電流源3レベルコンバータであり、イン ダクタを直流バスにもつフルブリッジ補助 コンバータ(インダクタセル)が並列に接続 される。この構成では、インダクタ電流をI<sub>L1</sub> = I<sub>DC</sub>/4、I<sub>L2</sub> = I<sub>DC</sub>/8、I<sub>L3</sub> = I<sub>DC</sub>/16、・・・とす る複数のインダクタセルを並列に挿入して 出力のレベル数を増大する。

④ ネスト構造をもつ電圧源マルチレベルコンバータとその双対回路
 図4は電圧源2
 レベルコンバータを2組用いた例である。このように複数のコンバータを入れ子のように挿入していくことでマルチレベル化を図る。このようなネスト構造を双対変換すると図5のような回路を新たに得ることができる。電圧源で構成した図4の回路と異なり、ネスティングの度合に一切関わらず、すべての直



図4 ネスト構造をもつ電圧源4レベルコンバータ



図5 電流源4レベルコンバータ(ネスト構造をもつ電 圧源4レベルコンバータの双対回路)



図6 電流源5レベルコンバータ(ネスト構造をもつ電 圧源5レベルコンバータの双対回路)

流電流源が同一電位に接続される。また,ス イッチング素子についても同様であるため, 複数の素子を駆動するために絶縁されたド ライブ回路は不要である。

ネスト構造をもつ電圧源マルチレベルコ ンバータは2レベルと3レベルの組合せでも 実現できる。この双対回路は図6のような構 成となる。このような新規トポロジーは,す べての直流電流源とスイッチング素子が共 通枝路に接続される。しかも,出力レベル数 を更に増加させる場合でも,その共通枝路上 に同一電位で並列多重化するだけで良いと いう利点がある。なお,この回路はフィッシ ュボーン構造と命名した。

(3) H ブリッジを活用した新トポロジー ① インダクタセルと H ブリッジ電流源 3 レ ベルコンバータの組み合わせ 図7にHブ リッジ3レベル電流源コンバータと並列に挿 入されたインダクタセルの組み合わせから なるマルチレベルコンバータを示す。ここで 取り上げる H ブリッジのほか,前述の図1に 示したような回路でも主回路となりえる。 ② DC 電流源モジュールと H ブリッジ電流 源 3 レベルコンバータの組み合わせ DC 電流源モジュールは図1や図7に既出の新規 トポロジーでも頻繁に出現する構成単位で ある。図8は複数の DC 電流源モジュールを





図 8 DC 電流源モジュールと H ブリッジ電流源 3 レベ ルコンバータを組み合わせたマルチレベルコンバータ

重畳し, 最終段で H ブリッジ電流源 3 レベル コンバータと組み合わせた例である。

(4) 新規トポロジー群の運転特性と従来方式 との比較

① フィッシュボーン構造電流源 3 レベルコ ンバータの運転特性 図1のフィッシュボ ーン構造を有する電流源 3 レベルコンバータ の出力電流とフィルタ後の負荷電圧波形を 図9に示す。直流電流源を10A一定に保持し, コンバータの出力電流指令値は 100 Hz の正 弦波, 100 kHz のキャリアでパルス幅変調し た。同図に示されているように出力電流は 3 レベルの PWM 波形となっており, その振幅 は電流源と一致している。

② フィッシュボーン構造電流源 5 レベルコ ンバータの運転特性 図6のフィッシュボ ーン構造電流源 5 レベルコンバータの波形を 図 10 に示す。出力電流は所望の 5 レベル PWM 波形となっており、中位のほか 0 レベ ルも良好に出力されている。図 11 は本コン バータの効率特性を示したものである。軽負 荷時にはスイッチング素子の導通損が相対 的に大きくなるため効率は低下するが、負荷 が重くなるに従って改善され、最大出力 1.42 kW 時には 92.7%の効率を達成している。

③ インダクタセルを利用した電流源 5 レベ ルコンバータの運転特性 図 12 は図 3 に 示したインダクタセルを利用した電流源 5 レ ベルコンバータの実験波形である。5 レベル の出力電流波形は若干ノイズが乗っている が, THD は 3.3 %と良好である。図 13 は本コ ンバータの効率特性を示したものである。負 荷消費電力が 800 W になるまで測定し,最高 効率は 92.7 %に達した。

 ④ H ブリッジと DC 電流源モジュールを組み合わせた電流源5 レベルコンバータの運転特性
 図 14は1個の DC 電流源モジュールをHブリッジ電流源3 レベルコンバータに重畳した各部電流波形を示しており,負荷への出力電流は良好な5 レベル波形となっている。 負荷消費電力が800 W となるまで測定した結果,最高効率 93.4%を記録した。



図 9 フィッシュボーン構造電流源 3 レベルコンバータ の出力波形



図 10 フィッシュボーン構造電流源 5 レベルコンバー タの出力波形



Efficiency (%)

図 11 フィッシュボーン構造電流源 5 レベルコンバー タの効率

⑤ インダクタにおける導通損の比較 図 16は出力波形のレベル数を横軸にとり、図1 のフィッシュボーン構造電流源3レベルコン バータにおける直流電流源のインダクタ導通 損を基準とした相対的なインダクタ導通 損を示したものである。フィッシュボーン構 造をもつトポロジーや DC 電流源モジュール とHブリッジからなるトポロジーは、出力電 流波形のレベル数が増加するに伴い急激に インダクタ導通損が減少する。

⑥ 使用素子数の比較 表1に従来の電流 源5レベルコンバータ(1)~(3)と本研究で創 出した5レベル新規トポロジー(4)~(7)の使 用素子数を比較した。DC電流源モジュール とHブリッジの組み合わせからなるトポロ ジーが高い優位性をもつ。

(5) まとめ

本研究を通じて以下の成果が得られた。

- 従来の回路構成,動作原理とは全く異なるマルチレベル電力変換器の新規トポロジー群を見出し、マルチレベル技術の枠組みを拡張,再構築できた。
- ② 従来方式と新規トポロジー群を半導体素 子数,受動素子数,電源数,絶縁ドライ ブ回路数,電力変換効率,実装や制御の 難易度などの観点から総合的に比較評価 し,それぞれの特徴を活かした応用に対 する技術的基盤を提供できた。
- ③ 新規トポロジー群の中から, SiC-MOSFET



図 12 インダクタセルを利用した電流源 5 レベルコン バータの出力波形



図 13 インダクタセルを利用した電流源 5 レベルコン バータの効率



図14 HブリッジとDC電流源モジュールを組み合わせ た電流源5レベルコンバータの出力波形



図15 HブリッジとDC電流源モジュールを組み合わせ た電流源5レベルコンバータの効率

に代表される次世代半導体素子を利用した電力変換器のあるべき姿を提示した。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 9 件, すべて査読あり)

- (1) <u>野口季彦</u>,和田哲朗,鹿野 将,小森健裕: 「効率とパワー密度の最大化を図った低 電圧駆動1.5kW,150,000 r/min超高速PMモ ータ」電気学会論文誌D(産業応用部門誌), 134 巻,641-648 頁,2014,DIO 10.1541/ieejias.134.641
- (2)<u>野口季彦</u>,水野知博,村田宗洋:「スイッ チングアシスト補助回路を用いた



 (1) インダクタセルと H ブリッジの組み合わせ (2) インダクタセルとフ イッシュボーン構造の組み合わせ (3) DC 電流源モジュールとHブリッジ の組み合わせ (4) フィッシュボーン構造
 図 16 インダクタ導通損の相対比較

	here	
表 1	各種コンパー	タの使用素子数の比較

マルチレベル 電力変換器	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
スイッチング 素子数	8	8	8	8	8	5	6
ダイオード数	8	8	8	8	10	6	10
直流電流源数	1	2	1	1	2	2	4
インダクタ数	3	2	5	2	3	2	4
絶縁ドライブ 電源数	4	4	4	4	4	3	1

(1) マルチセル (2) 並列 H ブリッジ (3) シングルレーティング (4) インダクタセルと H ブリッジの組み合わせ (5) インダクタセルとフィッシュボーン構造の組み合わせ (6) DC 電流源モジュールと H ブリッジの組み合わせ (7) フィッシュボーン構造

MOSFET の高速スイッチング法」電気学 会論文誌 D(産業応用部門誌), 133 巻, 1186-1192 頁, 2013, DIO 10.1541/ieejias.133.1186

- (3) 小原正樹, <u>野口季彦</u>:「巻線抵抗同定機 構を有する永久磁石同期モータの磁極位 置センサレス制御における誘起電圧変動 と磁極位置誤差の特性解析」電気学会論 文誌 D(産業応用部門誌),133 巻,812-820 頁,2013,DIO 10.1541/ieejias.133.812
- (4) 小原正樹, <u>野口季彦</u>:「モデル規範適応 システム基づく永久磁石モータのセンサ レス制御における磁極位置推定特性の改 善」電気学会論文誌 D(産業応用部門誌), 133 巻, 222-230 頁, 2013, DIO 10.1541/ieejias.133.222
- (5) Suroso, <u>Toshihiko Noguchi</u>, "Multilevel Current Waveform Generation Using Inductor Cells and H-Bridge Current-Source Inverter," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, pp.1090-1098, 2012, DIO 10.1109/TPEL.2010.2056933
- (6) 小原正樹, <u>野口季彦</u>:「内部永久磁石同 期モータの停止時磁極位置推定法」電気 学会論文誌 D(産業応用部門誌),132 巻, 1082-1083 頁, 2012, DIO 10.1541/ieejias.132.1082
- (7) <u>野口敏彦</u>,水野知博:「負荷短絡補助回路を用いた MOSFET の高速スイッチング法 —高周波ハーフブリッジインバータへの適用—」電気学会論文誌 D(産業応用部門誌),132巻,1080-1081頁,2012, DIO 10.1541/ieejias.132.1080
- (8) <u>野口敏彦</u>,水野知博:「負荷短絡補助回路 を用いたMOSFETの高速スイッチング法

ーチョッパへの適用と運転特性—」電気学 会論文誌D(産業応用部門誌),132巻, 598-599 頁,2012,DIO 10.1541/ieejias.132.598

 (9) Suroso, <u>Toshihiko Noguchi</u>, "Common-Emitter Topology of Multilevel Current-Source Pulse Width Modulation Inverter with Chopper-Based DC Current Sources," IET Power Electronics, vol.4, pp.759-766, 2011, DIO 10.1049/iet-pel.2010.0008 [学会発表](計 60 件)

 M. Aoyama, <u>T. Noguchi</u>, "Mathematical Analysis of Wound-Field Synchronous Motor Self-Excited by Space Harmonics," The 22nd International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM2014), Accepted, 2014年06月18日~20日, Hotel Continental Ischia, Ischia, Italy.

- (2) <u>T. Noguchi</u>, J. Xiang, "Off-Line Parameter Identification of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor by Searching Minimum Point of Current Norm Characteristics," The 22nd International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM2014), Accepted, 2014年06月18日~20日, Hotel Continental Ischia, Ischia, Italy.
- (3) M. Aoyama, <u>T. Noguchi</u>, "Mathematical Model of Novel Wound-Field Synchronous Motor Self-Excited by Space Harmonics," IEEJ International Power Electronics Conference 2014-Hiroshima (IPEC2014), 2014年05月18日~21日, 広島国際会議場 (広島市).
- (4) <u>T. Noguchi</u>, M. Murata, "High-Speed Switching Method of MOSFET Using Voltage Boost Auxiliary Circuit Fed by Gate Drive Power Supply -Applications to Chopper and Half-Bridge Inverter and Their Operation Characteristics-," IEEJ International Power Electronics Conference 2014-Hiroshima (IPEC2014), 2014年05月18日~21日, 広島 国際会議場(広島市).
- (5) M. Aoyama, <u>T. Noguchi</u>, "Theoretical Analysis of Novel Wound-Field Synchronous Motor Self-Excited by Space Harmonics," The 7th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD2014), 2014年04月08日~10日, Midland Hotel, Manchester, United Kingdom.
- (6) M. Aoyama, <u>T. Noguchi</u>, "Rare-Earth-Less Motor with Field Poles Excited by Space Harmonics — Theory of Self-Excitation and Magnetic Circuit Design—," The 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2013), 2013年11月10日~13 日, Austria Center Vienna, Vienna, Austria.
- (7) M. Aoyama, <u>T. Noguchi</u>, "Rare-Earth Free

Motor with Field Poles Excited by Space Harmonics —Current Phase-Torque Characteristics of Self-Excitation Synchronous Motor—," International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA2013), 2013年10 月 20 日  $\sim$  23 日, Avenida America Hotel, Madrid, Spain.

- (8) Suroso, H. Prasetijo, D. T. Nugroho, <u>T. Noguchi</u>, "New Five Level Current-Source PWM Inverter for Grid Connected Photovoltaics," International Conference on Information Technology and Electrical Engineering 2012 (CITEE2012), 2012年7月 12 日, Gedung KPFT Fakultas Teknik Universitas, Indonesia.
- (9) <u>T. Noguchi</u>, T. Mizuno, "High-Speed Switching Operation of MOSFETs Using Auxiliary Circuit Shorting Load," International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA2013), 2012 年 11 月 11 日~14 日, The Best Western Premier Hotel Nagasaki (長崎市).
- (10) Suroso, <u>T. Noguchi</u>, "A Multilevel Voltage Source Inverter Using H-Bridge and Two-Level Power Modules with a Single Power Source," The 9th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS2011), 2011 年 12 月 5 日~8 日, Amara Hotel, Singapore.
- ほか国内学会発表 50 件(内,招待講演 4 件) 〔図書〕(計 3 件)
- (1) 分担執筆(大久保仁,<u>野口季彦</u>ほか): 「電気工学ハンドブック」オーム社,総 頁数 2706, 2013 年
- (2) 分担執筆(近藤圭一郎, <u>野口季彦</u>ほか):
   「電気学会技術報告 新応用分野に拡大 する可変速交流ドライブ技術」電気学会, 総頁数 62, 2012 年
- (3) 分担執筆(森本雅之, <u>野口季彦</u>ほか): 「電気自動車の最新制御技術」エヌ・ティー・エス,総頁数 256, 2011 年
   〔産業財産権〕
- ○出願状況(計 0 件)
- ○取得状況(計 0 件)
- 〔その他〕
- ホームページ等
- 静岡大学 野口研究室
- http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/~ttnogut/index.html

6.研究組織
(1)研究代表者 野口 敏彦 静岡大学・工学研究科・教授 研究者番号:10237828
(2)研究分担者 なし
(3)連携研究者 なし